

首页 学院概况 公告动态 教师队伍 教学工作 质量工程 学术研究 实验管理 仿真实验 党建工作 团学工作 学习园地 招生就业 下载专区 网站地图

当前位置: 首页>>教师队伍>>教师介绍>>正文

自兴发老师简介

2018-01-22 19:08

- ≥ 刘艳老师简介
- ▶ 夏绍先老师简介
- 斯勇老师简介
- 動 颜茜老师简介
- ▶ 向文丽老师简介
- ≥ 祝菲霞老师简介

目兴发老帅简介

1. 个人基本情况



自兴发,男,1971年4月生,云南楚雄人,研究生,副教授。主要从事电子信息专业的专业课教学,研究方向为Cu₂O薄膜材料及其光电器件。

2. 教学工作及成果

主要承担模拟电子技术、数字电子技术、通信原理、数字信号处理及电子设计与制作等专业课的教学;2007年、2009年及2011年先后指导学生参加全国大学生电子设计竞赛,分别获云南赛区三等奖、二等奖及参赛进步奖;2010年11月,被学校授予第三届"师德标兵"荣誉称号。

3. 科研工作及成果

主持完成校级教改项目《电子信息专业创新性人才培养模式构建》、校级重点项目《基于表面增强的病理特征信息处理》的项目研究;在光电子. 激光、人工晶体学报、西南大学学报(自然科学版)及Advanced Materials Research等国内外专业期刊发表论文12篇(EI检索8篇、中文核心4篇),获国家发明专利4项(发明专利3项、实用新型专利1项)。

发表论文:

- 1. 退火Cu₂O薄膜的结构及光学特性,光电子. 激光, 2015, 26(10): 1931-1936; (第1作者, EI期刊 收录)
- 2. 氧氩流量比对RF溅射ZnO:Mg薄膜结构及光学性能的影响,光电子. 激光, 2015, 26(5): 883-888; (第1作者, EI期刊收录)
- 3. 溅射压强对ITO/Cu₂O复合膜结构和光学性能的影响, 光电子. 激光, 2014, 25(12): 2310-2314; (第1作者, EI期刊收录)
- 4. RF磁控溅射制备 N掺杂Cu₂O薄膜及光学特性研究,光电子·激光,2014,25(9):1727-1731;(第1作者,EI期刊收录)
- 5. Structure and Optical Property of Cu₂O:N Thin Film Deposited by Reactive Pulse Magnetron Sputtering, Advanced Materials Research, 2014, 951: 104-108; (第1作者, EI期刊收录)
- 6. Effects of Substrate Temperature on Structure and Optical Property of Cu2O:N Thin Film Deposited by Reactive Pulse Magnetron Sputtering, Applied Mechanics and Materials, 2014, 540: 25-29; (第1作者, EI 期刊收录)
- 7. 溅射功率对脉冲磁控溅射沉积 Cu_2O 薄膜结构和光学性能的影响,人工晶体学报,2014,43(4): 1003-1008;(第1作者,EI期刊收录)
- 8. 氧氫比及基底温度对脉冲磁控溅射 Cu_2 O薄膜结构和光学性能的影响,人工晶体学报,2013,42(9):1802-1807;(第1作者,EI期刊收录)
- 9. CZTS薄膜太阳电池的研究进展,电源技术,2014,53(7):263-268;(第1作者,中文核心)
- 10. Cu(InAl)Se,薄膜太阳电池的研究进展,材料导报,2012,26(11):200-202;(第1作者,中文核心)

- 11. 基于多周期相关的ECG信号压缩编码方法,西南大学学报(自然科学版),2011,33(9):61-66;(第1作者,中文核心)
- 12. 基于静电自组装银膜的急性粒白血病氧合血红蛋白表面增强拉曼光谱研究,光散射学报,2010,22 (4):298-304;(第1作者,中文核心)

授权专利:

- 1. 一种Cu(InAl)Se₂ (CIAS) 薄膜的化学制备工艺,国家知识产权局,发明专利,专利号: ZL 2011 1 0439134. X,授权公告日:2015年05月20日;(第2发明人)
- 2. 一种太阳电池复合减反射膜的制备方法,国家知识产权局,发明专利,专利号:ZL 2013 1 0016893.4,授权公告日:2015年02月04日;(第2发明人)
- 3. 一种太阳电池吸收层薄膜材料的制备方法,国家知识产权局,发明专利,专利号: ZL201110409449. X,授权公告日: 2013年09月11日; (第2发明人)
- 4. 一种沼气转储装置, 国家知识产权局, 实用新型专利,专利号: ZL200720105083.6, 授权公告日: 2008年09月3日。(第5发明人)

【关闭窗口】

物理与电子科学学院